

Список публикаций ведущей организации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)»

1. Avrov, DD; Gorlyak, AN; Lebedev, AO; Luchinin, VV; Markov, AV; Osipov, AV; Panov, MF; Kukushkin, SA  
Comparative Ellipsometric Analysis of Silicon Carbide Polytypes 4H, 15R, and 6H Produced by a Modified Lely Method in the Same Growth Process  
TECHNICAL PHYSICS LETTERS, Том: 46 Выпуск: 10, Стр.: 968-971, DOI: 10.1134/S1063785020100028, Опубликовано: 2020
2. Osipov, AV; Grashchenko, AS; Gorlyak, AN; Lebedev, AO; Luchinin, VV; Markov, AV; Panov, MF; Kukushkin, SA  
Investigation of the Hardness and Young's Modulus in Thin Near-Surface Layers of Silicon Carbide from the Si- and C-Faces by Nanoindentation  
TECHNICAL PHYSICS LETTERS, Том: 46 Выпуск: 8, Стр.: 763-766, DOI: 10.1134/S106378502008012X, Опубликовано: 2020
3. Gareev, KG; Bagrets, VS; Golubkov, VA; Ivanitsa, MG; Khmel'nitskiy, IK; Luchinin, VV; Mikhailova, ON; Testov, DO  
Synthesis and Characterization of Polyaniline-Based Composites for Electromagnetic Compatibility of Electronic Devices  
ELECTRONICS, Том: 9, Выпуск: 5, Номер статьи: 734, DOI: 10.3390/electronics9050734, Опубликовано: 2020
4. Alekseev, NI; Bagrets, VV; Broyko, AP; Korlyakov, AV; Kalenov, VE; Luchinin, VV; Sevostyanov, EN; Testov, DO; Khmel'nitskiy, IK  
Ionic Polymer Electroactive Actuators Based on the MF-4SK Ion-Exchange Membrane. Part 1. Ionic Polymer-Metal Composites  
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, Том: 61, Выпуск: 4, Стр.: 601-608, DOI: 10.1134/S0022476620040149, Опубликовано: 2020
5. Alekseev, NI; Bagrets, VS; Broyko, AP; Korlyakov, AV; Luchinin, VV; Kalenov, VE; Sevostyanov, EN; Khmel'nitskiy, IK  
Ionic Polymer Electroactive Actuators Based on the MF-4SK Ion-Exchange Membrane. Part 2. Ionic Polymer-Graphene Composites  
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, Том: 61, Выпуск: 4, Стр.: 609-616, DOI: 10.1134/S0022476620040150, Опубликовано: 2020
6. Mikhaylov, AI; Afanasyev, AV; Ilyin, VA; Luchinin, VV; Reshanov, SA; Schoner, A  
High-Power 4H-SiC MOSFET with an Epitaxial Buried Channel  
SEMICONDUCTORS, Том: 54, Выпуск: 1, Стр.: 122-126, DOI: 10.1134/S1063782620010157, Опубликовано: 2020